

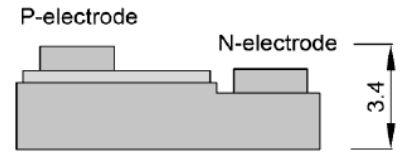
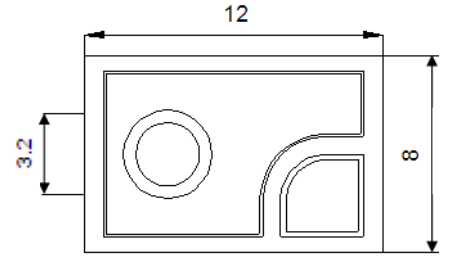


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性

◆ 物理参数:

P 电极	金
N 电极	金
芯片尺寸	12mil × 08mil (305 ± 25μm × 203 ± 25μm)
芯片厚度	3.4mil (85 ± 15μm)
焊盘尺寸	3.2mil (80 ± 10μm) in diameter



单位: mil

◆ 光电参数: (Tc=22°C, If=20mA)

产品型号	波长范围 (λ <sub>D</sub> , nm)		工作电压 (V <sub>F</sub> , V)	反向漏电流 (I <sub>R</sub> , μA) @V <sub>R</sub> =10V	半波宽度 (Δλ, nm)	最大电流 (I <sub>F</sub> , mA) DC
	Min	Max				
S-12DBAUP*-445E**	445	450	≤3.4	≤2	≤30	30
S-12DBAUP*-450E**	450	455				
S-12DBAUP*-455E**	455	460				
S-12DBAUP*-460E**	460	465				
S-12DBAUP*-465E**	465	470				

◆ 光强等级: (Tc=22°C, If=20mA)

等级	...	D16	D17	D18	D19	D20	D21	...
Iv scale (mW)	...	14~15.5	15.5~17	17~18.5	18.5~20	20~21.5	21.5~23	...

◆ 其它说明:

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下的测试参数, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C, 持续时间小于 10 秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ±1.0nm
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片